









	<h2 style="color: #E67E22;">R6035KNZ1C9</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: R6035KNZ1C9</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: NCH 600V 35A POWER MOSFET</p> <hr/> <p>Datenblätter:  R6035KNZ1C9.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6035KNZ1C9
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 600V 35A POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	102 mOhm @ 18.1A, 10V
Verlustleistung (max)	379W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

R6035KNZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6035KNZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6035KNZ1C9 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6035KNZ1C9 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6035KNZ1C9 LAPIS Semiconductor NCH 600V 35A POWER MOSFET</p>	 <p>R6031435ESYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 350A DO205</p>	 <p>R6035KNZC8 Rohm Semiconductor NCH 600V 35A POWER MOSFET</p>	 <p>R60400-1CR Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>
 <p>R60400-1STRM Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p>R60400-3CR Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p>R6031235ESYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.2KV 350A DO205</p>	 <p>R6031425HSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 250A DO205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6035KNZ1C9 LAPIS Semiconductor	R6035KNZ1C9 Datenblatt	R6035KNZ1C9-Datenblätter	R6035KNZ1C9 PDF	LAPIS Semiconductor R6035KNZ1C9
R6035KNZ1C9 Electronic	R6035KNZ1C9-Komponenten	R6035KNZ1C9-Verteiler	R6035KNZ1C9-Bild	R6035KNZ1C9-Teil
R6035KNZ1C9 Preis	R6035KNZ1C9 Hersteller	R6035KNZ1C9 Bild	R6035KNZ1C9 Aktie	R6035KNZ1C9 Inventar
R6035KNZ1C9 Neu	R6035KNZ1C9 Original	R6035KNZ1C9 garantiert	R6035KNZ1C9 RFQ	R6035KNZ1C9 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited